

glō bestellt G5+ MOCVD-Anlage für Micro-LED-Produktion

AIX G5+ als Referenzanlage für Micro-LED-Anwendungen

Herzogenrath, 19. September 2017 – AIXTRON SE (FSE: AIXA), ein weltweit führender Hersteller von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, gibt heute bekannt, dass es einen Auftrag des schwedisch-amerikanischen Unternehmen glō-USA, Inc. über eine Anlage des Typs AIX G5+ erhalten hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Vermarktung von Micro-LED-Produkten, die auf ihrer eigenen fehlerfreien Galliumnitrid (GaN) Nanodraht-Technologie basieren. Solche 3D-Strukturen ermöglichen das Wachstum von Micro-LEDs unter Beibehaltung der Zuverlässigkeit eines anorganischen Materialsystems. AIXTRONs AIX G5+ Planetary Reactor® System wurde im Rahmen der strategischen Expansion von glō ausgewählt und wird in einer Konfiguration von 8x150 mm im Lauf des vierten Quartals 2017 geliefert.

Alle führenden Display-Hersteller haben die Micro-LED-Technologie als Herausforderer der aktuell genutzten Display-Technologie für die nächste Generation von Konsumgütern auf ihre Agenda gesetzt. Micro-LED-Displays bestehen aus einer großen Anzahl von mikrometergroßen LEDs, die individuelle Sub-Pixel-Elemente bilden. Im Vergleich zu den derzeit verfügbaren LCD- und OLED-Technologien bieten Micro-LED-Displays einen äußerst niedrigen Energieverbrauch, während sie gleichzeitig höchste Pixel-Dichte, Kontrastverhältnis und Helligkeit aufweisen und daher neue Horizonte für mobile Konsumgüter und Premium TV-Displays öffnen.

Fariba Danesh, CEO von glō, sagt: „Auf der Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung sowie dem Know-how im Bereich der Nanotechnologie, haben wir eine wegweisende dreifarbige Micro-LED-Displaytechnologie entwickelt. Unsere drei Farbpixel werden ausschließlich mittels GaN-Halbleitermaterialien hergestellt. Wir konzentrieren uns nun darauf, diese spannende Technologie in die Massenproduktion zu überführen. Über die Epitaxie-Struktur hinaus, verlangt die Herstellung von Micro-LEDs skalierbare Prozesse, straffe Heterogenität und Partikel-Kontrolle der Epitaxie-Wafer, um eine größtmögliche Ausbeute und damit die kosteneffiziente Weitergabe an unsere Partner im Bereich Micro-LEDs zu ermöglichen. AIXTRONs AIX G5+ MOCVD-Anlage erfüllt aufgrund ihres Batch Reactor-Konzepts alle diese Anforderungen unter gleichzeitiger Einhaltung eines wirtschaftlichen Produktionsbetriebs. Daher freuen wir uns bei diesen vielversprechenden Anwendungen auf eine enge Zusammenarbeit mit AIXTRON.“

„Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns glō entgegen bringt und sind zuversichtlich, dass unsere Technologie die Bedürfnisse des Unternehmens bestmöglich unterstützt. Unsere AIX G5+ genießt einen hervorragenden Ruf als Referenzanlage für Anwendungen im Bereich Micro-LED, da sie die einzige Technologie auf dem Markt ist, die sowohl eine on-wafer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Corporate Communications

AIXTRON SE, Dornkaulstr. 2, 52134 Herzogenrath, Germany

PHONE +49 (2407) 9030-444 FAX +49 (2407) 9030-445

E-MAIL info@aixtron.com WEB www.aixtron.com

Homogenitätskontrolle als auch niedrige Partikelniveaus und einzigartige erweiterte Funktionen wie die Wafer-Level-Temperaturkontrolle mittels Auto-Feed Forward (AFF) liefert. Damit unterstützt unsere Anlage die hohen Anforderungen in der Herstellung von Micro-LEDs", sagt Dr. Bernd Schulte, Vorstand der AIXTRON SE.

Über AIXTRON

Die AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT[®], AIXTRON[®], Atomic Level SolutionS[®], Close Coupled Showerhead[®], CRIUS[®], Gas Foil Rotation[®], Optacap[™], OVPD[®], Planetary Reactor[®], PVPD[™], TriJet[®]

Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) sind im Internet unter www.aixtron.com verfügbar.

Über glö

glö basiert auf zehnjähriger Forschungsarbeit, die von Professor Lars Samuelson am Nanometer Structure Consortium der Universität von Lund (Schweden) begonnen wurde. 2010 gründete glö eine Produktlinie für F&E und Produktentwicklung Sunnyvale (Kalifornien, USA). Geführt von einem sehr erfahrenen Management-Team konzentriert sich das Unternehmen auf die Lieferung von Micro-LED-Produkten ab 2018.

Weitere Informationen sind unter <http://www.glo.se/> verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichtete Aussagen geben die gegenwärtigen Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON Managements, von denen zahlreiche außerhalb des AIXTRON Einflussbereiches liegen, wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind.. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei Abweichungen geht die deutsche maßgebliche Fassung des Dokuments der englischen Übersetzung vor.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Corporate Communications

AIXTRON SE, Dornkaulstr. 2, 52134 Herzogenrath, Germany

PHONE +49 (2407) 9030-444 FAX +49 (2407) 9030-445

E-MAIL info@aixtron.com WEB www.aixtron.com